МГТУ им. Баумана

Дисциплина основы электроники

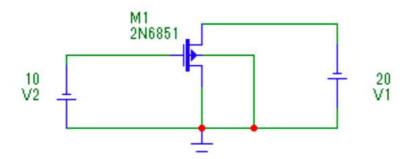
Защита лабораторной работы №7

Работу выполнила: студентка группы ИУ7-31Б Варламова Екатерина

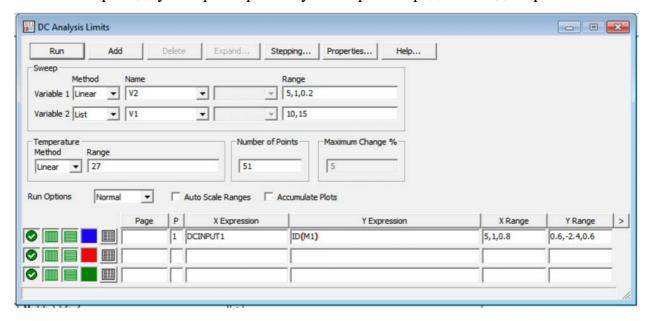
Номер по журналу: 4

Номер варианта: 7

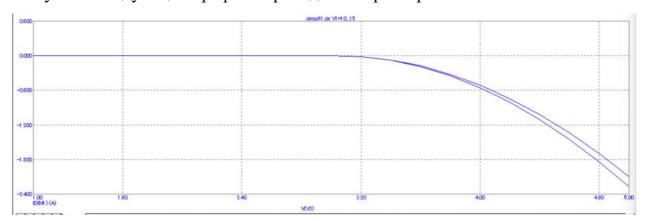
Соберём схему:



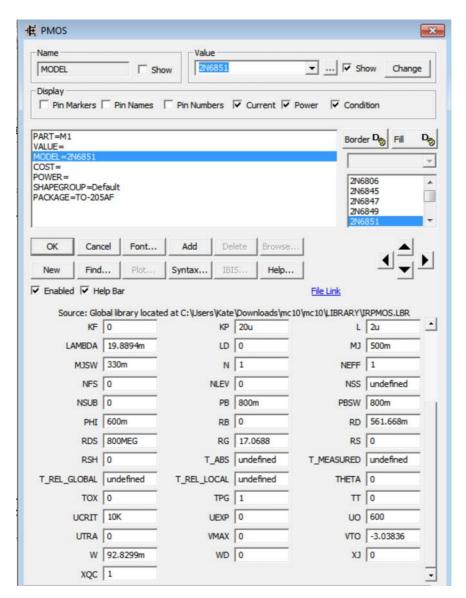
Снимем переходную характеристику. Настроим пределы моделирования:



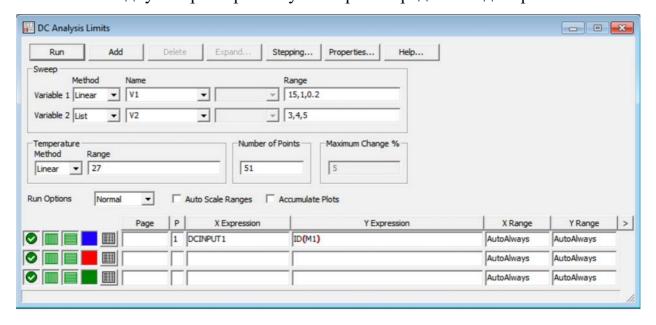
Получаем следующий график переходных характеристик:



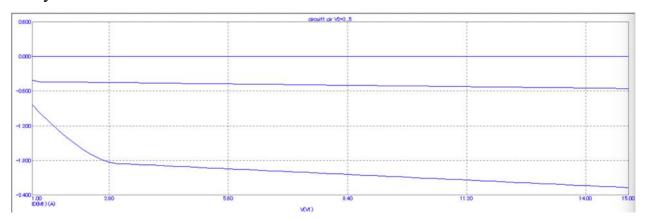
Из графика видно, что напряжение отсечки на данном транзисторе равно примерно -3 В (источник перевёрнут), что совпадает с параметром VTO транзистора:



Снимем выходную характеристику. Настроим пределы моделирования:



Получаем:



При Uзи = -3 В транзистор еще закрыт, на стоке ток нулевой.

При -4 В на затворе ток уже не нулевой.

При -5 В уже можно выделить омическую область и область насыщения (она начинается примерно с напряжения 2.8 В на стоке).